

半導体事業譲渡に伴うお知らせ

パナソニック株式会社の半導体事業は、2020年9月1日にNuvoton Technology Corporation（以下、Nuvoton）へ譲渡され、パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社は、ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社（以下、NTCJ）としてNuvotonグループの会社となりました。

これに伴い、2020年9月1日以降、半導体商品はNTCJ製となりますが、引き続き、パナソニック株式会社を通じた販売を継続いたします。

本ドキュメントにつきましては、製造元であるNTCJが発行しています。

本文中にパナソニック/パナソニック セミコンダクターソリューションズの記述がございましたら、NTCJに読み替えてご使用ください。

※ “本書に記載の技術情報および半導体のご使用にあたってのお願いと注意事項”を除く

ヌヴォトン テクノロジージャパン株式会社



FK4B01100L

Single N-channel MOS FET

For load switching circuits

■ Features

- Low Drain-source ON resistance: RDS(on) typ. = 27 mΩ (VGS = 2.5 V)
- CSP (Chip Size Package)
- RoHS compliant (EU RoHS / MSL: Level 1 compliant)

■ Marking Symbol: 1A

■ Packaging

Embossed type (Thermo-compression sealing) : 20 000 pcs / reel (standard)

■ Absolute Maximum Ratings Ta = 25 °C

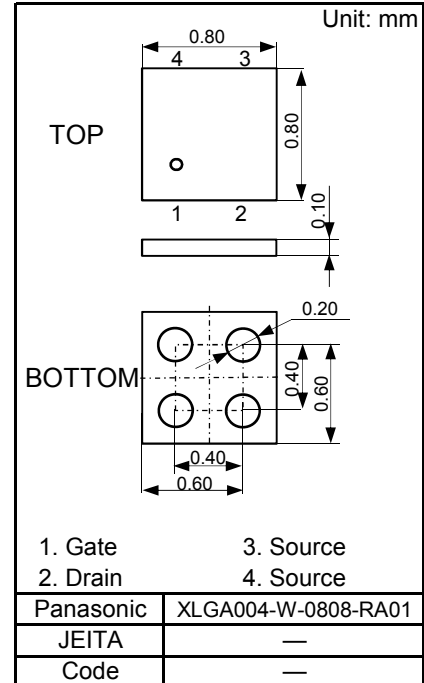
Parameter	Symbol	Rating	Unit
Drain-Source Voltage	VDS	12	V
Gate-Source Voltage	VGS	±8	V
Drain Current	ID1 ^{*1}	3.4	A
	ID2 ^{*2}	5.2	
	ID3 ^{*3}	6.5	
Peak Drain Current	IDp1 ^{*1*4}	27	A
	IDp2 ^{*2*4}	41	
	IDp3 ^{*3*4}	52	
Power Dissipation	PD1 ^{*1}	0.36	W
	PD2 ^{*2}	0.82	
	PD3 ^{*3}	1.3	
Channel Temperature	Tch	150	°C
Operating Ambient Temperature	Topr	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature	Tstg	-55 ~ +150	°C

Note *1 FR4 board (25.4mm×25.4mm×t1.0mm), Min Cu 36mm² Copper

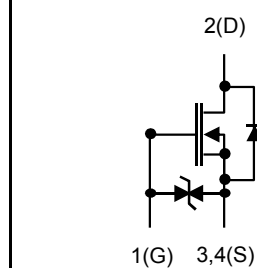
*2 FR4 board (25.4mm×25.4mm×t1.0mm), Full Cu

*3 Ceramic substrate (70mm×70mm×t1.0mm)

*4 t = 10 μs, Duty Cycle < 1%



■ Internal Connection



■ Electrical Characteristics Ta = 25 °C ± 3 °C

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	VDSS	ID = 1 mA, VGS = 0	12			V
Zero Gate Voltage Drain Current	IDSS	VDS = 12 V, VGS = 0			10	μA
Gate-Source Leakage Current	IGSS	VGS = ±8 V, VDS = 0 V			±10	μA
Gate Threshold Voltage	Vth	ID = 236 μA, VDS = 10 V	0.3		1.0	V
Drain-Source ON Resistance	RDS(on)	ID = 1.5 A, VGS = 4.5 V		22	30	mΩ
		ID = 1.0 A, VGS = 2.5 V		27	40	
		ID = 0.5 A, VGS = 1.8 V		33	56	
		ID = 0.25 A, VGS = 1.5 V		43	99	
Input Capacitance ^{*1}	Ciss	VDS = 10 V		275		pF
Output Capacitance ^{*1}	Coss	VGS = 0		100		
Reverse Transfer Capacitance ^{*1}	Crss	f = 1MHz		70		
Turn-on delay time ^{*1,*2}	td(on)	VDD = 6 V VGS = 0 to 4.5 V ID = 1.0 A		7		ns
Rise time ^{*1,*2}	tr			14		
Turn-off delay time ^{*1,*2}	td(off)			165		
Fall time ^{*1,*2}	tf			76		
Total Gate Charge ^{*1}	Qg		VDD = 6 V		5.8	
Gate to Source Charge ^{*1}	Qgs	VGS = 4.5 V		0.75		nC
Gate to Drain Miller Charge ^{*1}	Qgd	IS = 1.0 A		0.95		nC
Body Diode Forward Voltage	VF(D-S)	IF = 0.2A, VGS = 0V		0.6	1.2	V

Note Measuring methods are based on JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD JIS C 7030 Measuring methods for transistors.

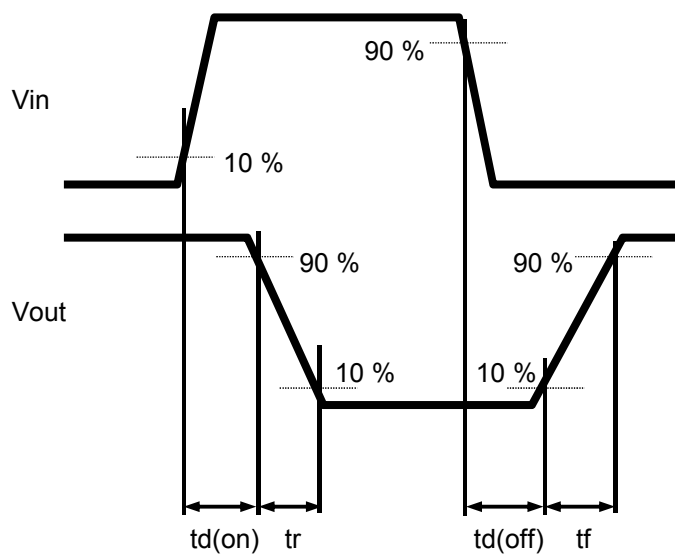
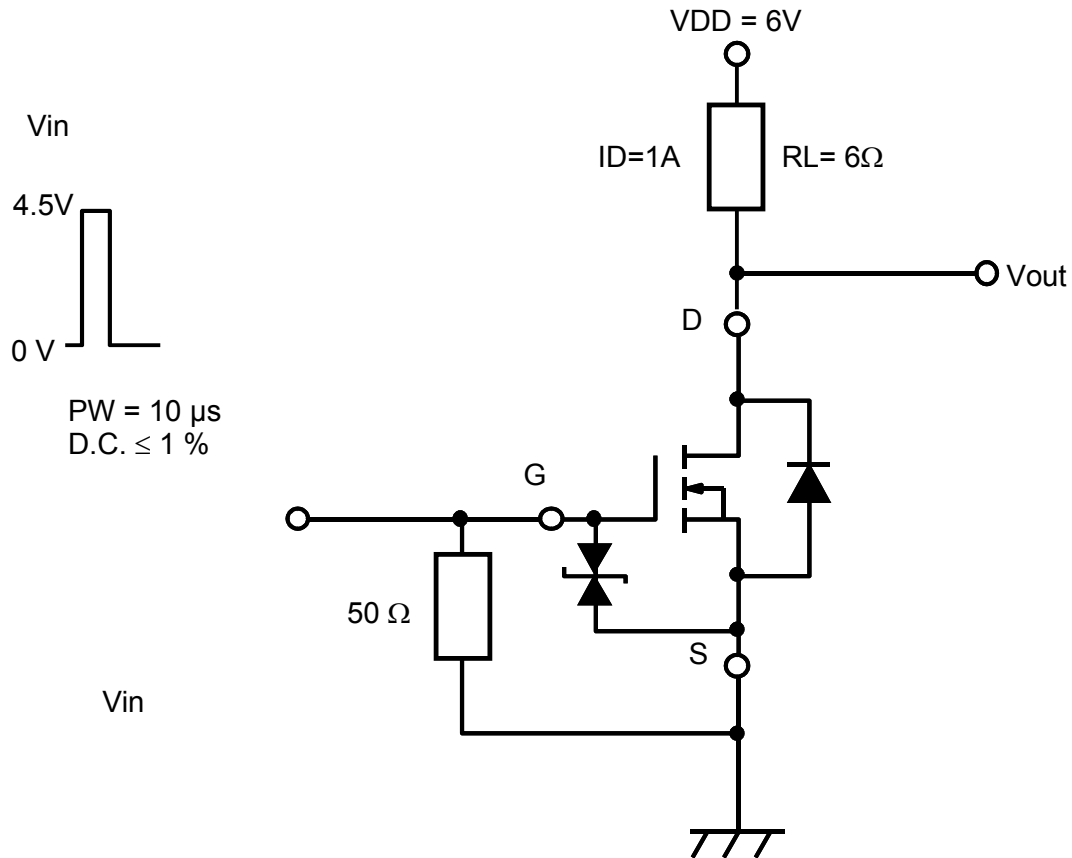
*1 Guaranteed by design, not subject to production testing

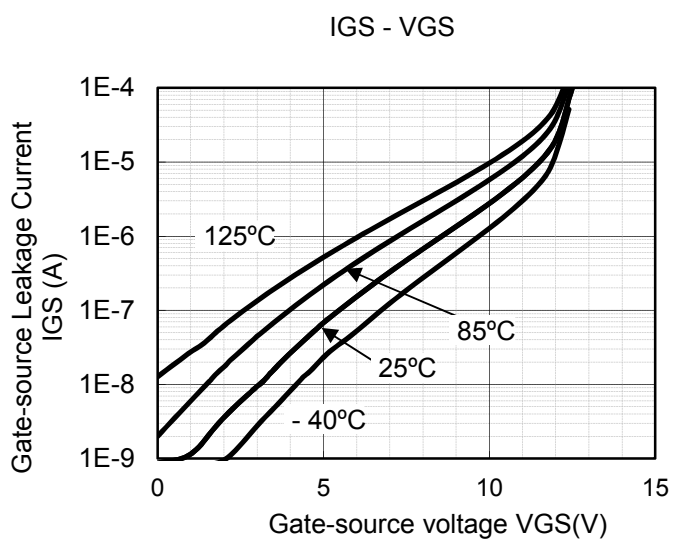
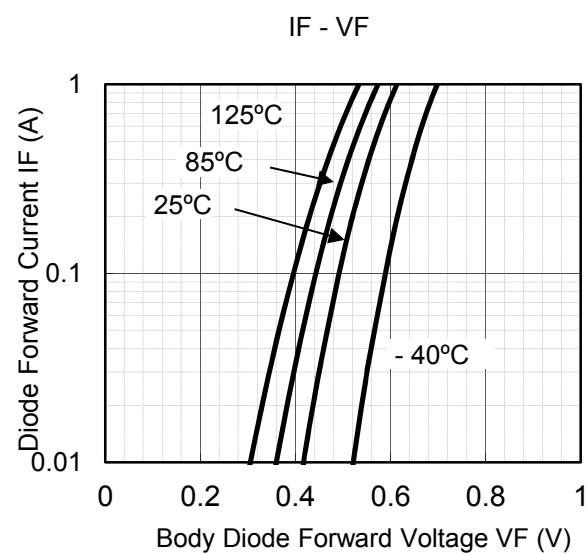
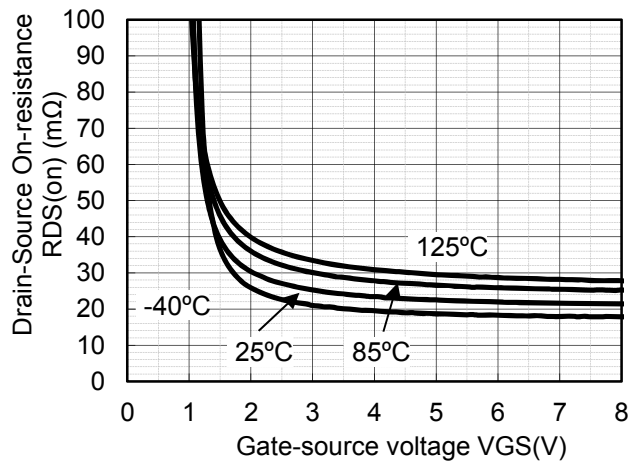
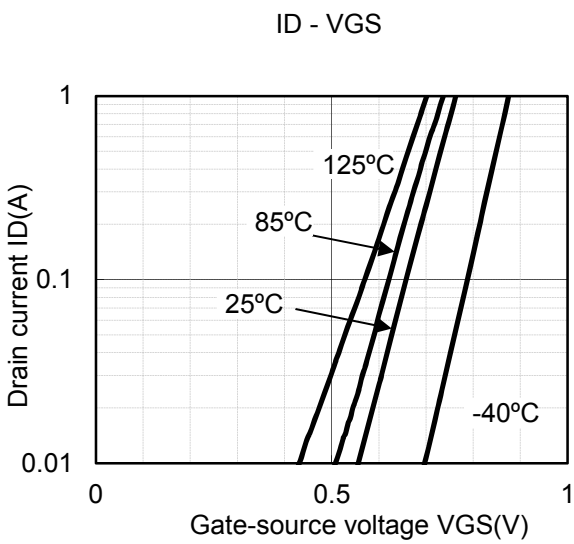
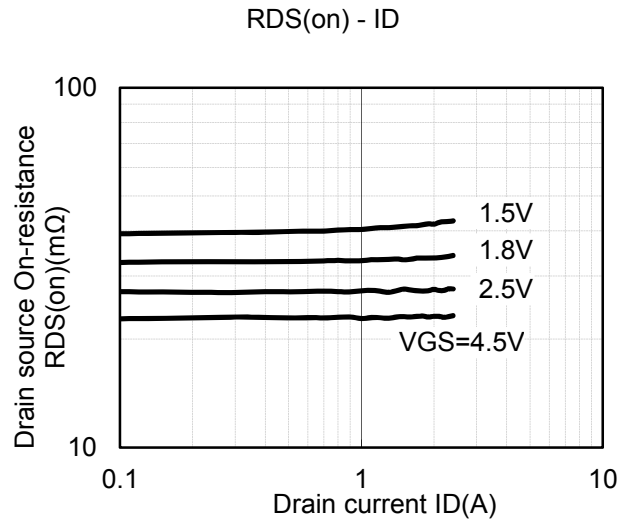
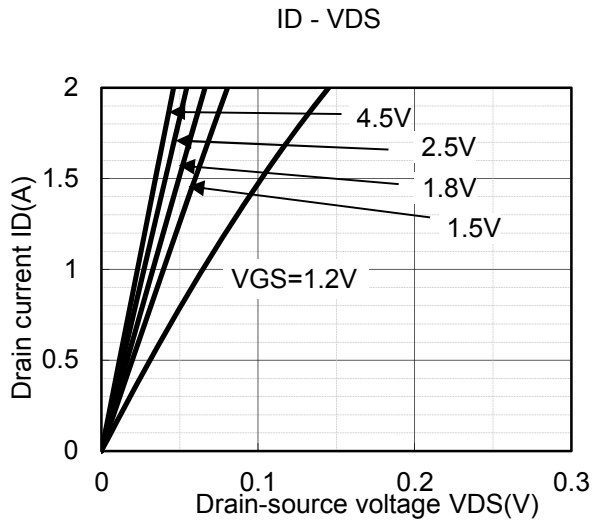
*2 Measurement circuit for Turn-on delay time / Rise time / Turn-off delay time / Fall time

■ Electrical State Discharge Characteristics

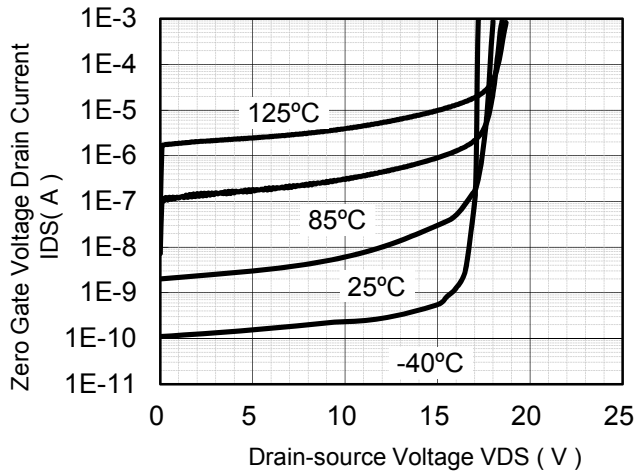
Standard	Test Type	Symbol	Conditions	Class	Value	Unit
AEC-Q101-001	Human body model	HBM	C = 100 pF, R = 1.5 kΩ	H1C	>1k to 2k	V
	Machine model	MM	C = 200 pF, R = 0 Ω	M2	>100 to 200	V

Note2: Measurement circuit

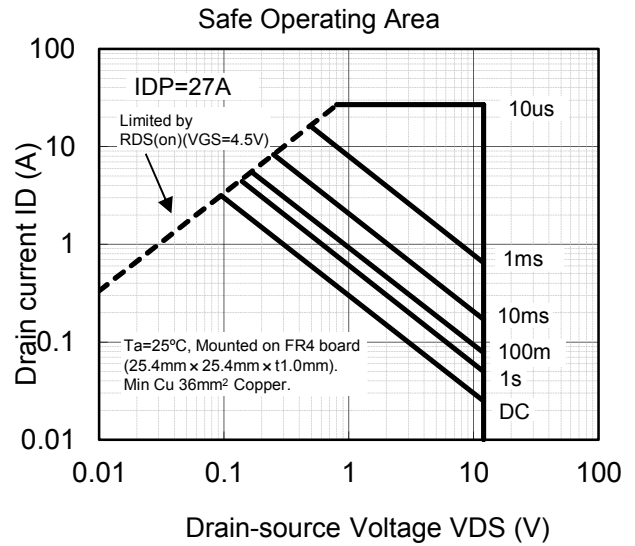
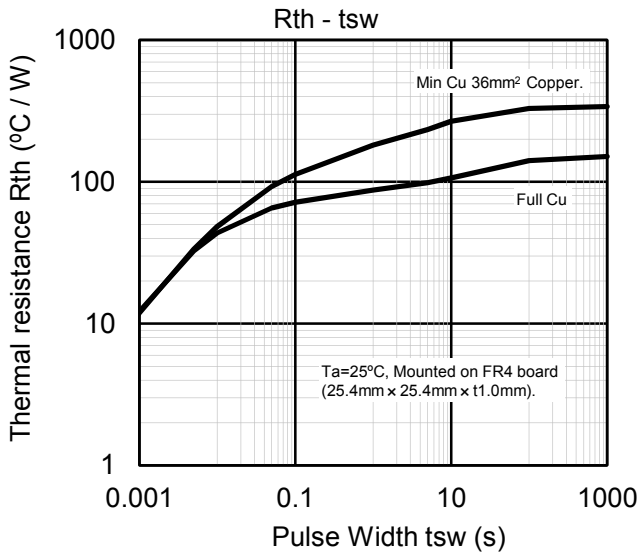
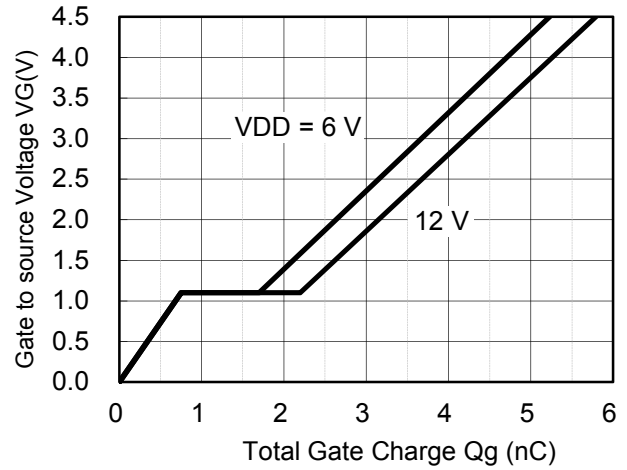




IDS - VDS

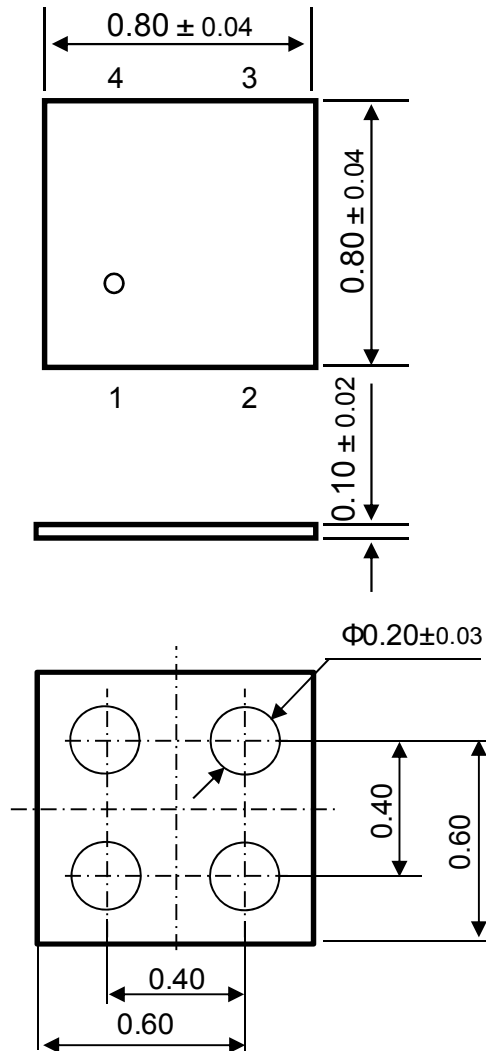


Dynamic Input/Output Characteristics

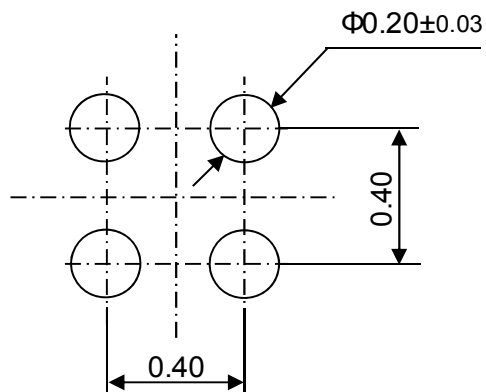


■ XLGA004-W-0808-RA01

Unit: mm



■ Land Pattern (Reference)



本書に記載の技術情報および半導体のご使用にあたってのお願いと注意事項

- (1) 本書に記載の製品および技術情報を輸出または非居住者に提供する場合は、当該国における法令、特に安全保障輸出管理に関する法令を遵守してください。
- (2) 本書に記載の技術情報は、製品の代表特性および応用回路例などを示したものであり、それをもってパナソニック株式会社、ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社または他社の知的財産権もしくはその他の権利の許諾を意味するものではありません。したがって、上記技術情報のご使用に起因して第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責任を負うものではありません。
- (3) 本書に記載の製品は、一般用途(事務機器、通信機器、計測機器、家電製品など)、もしくは、本書に個別に記載されている用途に使用されることを意図しております。
特別な品質、信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途 — 特定用途(車載機器、航空・宇宙用、輸送機器、交通信号機器、燃焼機器、医療機器、安全装置など)でのご使用を想定される場合は事前に当社営業窓口までご相談の上、使用条件等に関して別途、文書での取り交わしをお願いします。文書での取り交わしなく使用されたことにより発生した損害などについては、当社は一切の責任を負いません。
- (4) 本書に記載の製品および製品仕様は、改良などのために予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。したがって、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新の製品規格書または仕様書をお求め願ひ、ご確認ください。
- (5) 設計に際しては、絶対最大定格、動作保証条件(動作電源電圧、動作環境等)の範囲内でご使用いただきますようお願いいたします。特に絶対最大定格に対しては、電源投入および遮断時、各種モード切替時などの過渡状態においても、超えることのないように十分にご検討をお願いいたします。保証値を超えてご使用された場合、その後発生した機器の故障、欠陥については当社として責任を負いません。
また、保証値内のご使用であっても、半導体製品について通常予測される故障発生率、故障モードをご考慮の上、当社製品の動作が原因でご使用機器が人身事故、火災事故、社会的な損害などを生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などのシステム上の対策を講じていただきますようお願いいたします。
- (6) 製品取扱い時、実装時およびお客様の工程内における外的要因(ESD、EOS、熱的ストレス、機械的ストレス)による故障や特性変動を防止するために、使用上の注意事項の記載内容を守ってご使用ください。分解後や実装基板から取外し後に再実装された製品に対する品質保証は致しません。
また、防湿包装を必要とする製品は、保存期間、開封後の放置時間など、個々の仕様書取り交わしの折に取り決めた条件を守ってご使用ください。
- (7) 本書に記載の製品を他社へ許可なく転売され、万が一転売先から何らかの請求を受けた場合、お客様においてその対応をご負担いただきますことをご了承ください。
- (8) 本書の一部または全部を当社の文書による承諾なしに、転載または複製することを堅くお断りいたします。